

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年12月12日(2013.12.12)

【公開番号】特開2008-172195(P2008-172195A)

【公開日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【年通号数】公開・登録公報2008-029

【出願番号】特願2007-265550(P2007-265550)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/788 (2006.01)

H 0 1 L 29/792 (2006.01)

H 0 1 L 21/8247 (2006.01)

H 0 1 L 27/115 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 3 7 1

H 0 1 L 27/10 4 3 4

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年9月6日(2013.9.6)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0024

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0024】

さらに、図1Bに示されるように、縦型チャネルメモリー100は基板110aの上に位置する厚膜酸化物層150を持つ。本発明の本実施形態においては、厚膜酸化物層150は酸化ケイ素からできている。厚膜酸化物層150は、基板110aが電氣的に接続されるのを防ぐことにより、リーク電流の発生を防止する。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0044

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0044】

次に、図5Fを参照する。厚膜酸化物層150は、基板表面が電氣的に接続されるのを防ぐことにより、リーク電流の発生を防止する。工程606に示されているように、チャネル112の上にある第二窒化物パターン物層130bとパッド酸化物層120aからなるキャップ層140が取り除かれる。この工程は、熱リン酸( $H_3PO_4$ )で達成することも可能である。その間に、好ましくは、パッド酸化物層120aが取り除かれる。この工程は、フッ化水素酸(HF)で達成することができる。第二窒化物パターン層130bとパッド酸化物層120aの除去は、厚い酸化物層150の形成の前でも後でもよい。